



3.2 阻值範圍: < 1Ω

型別	額定功率	最高額定電流	最高過負荷電流	T.C.R (ppm / °C) 溫度係數	阻值範圍	
					F(±1%) E-24、E-96	G(±2%)、J(±5%) E-24
RTH02 (0402)	1/10W	2A	5A	±1500	25 mΩ ≤ R < 37 mΩ	
				±1200	37 mΩ ≤ R < 60 mΩ	
				±600	60 mΩ ≤ R < 200 mΩ	
				±300	200 mΩ ≤ R < 400 mΩ	
				±250	400 mΩ ≤ R < 600 mΩ	
				±200	600 mΩ ≤ R < 1000 mΩ	
RTH03 (0603)	1/8W	3.5A	8.84A	±1500	10 mΩ ≤ R < 37 mΩ	
				±1200	37 mΩ ≤ R < 60 mΩ	
				±600	60 mΩ ≤ R < 100 mΩ	
				±300	100 mΩ ≤ R < 200 mΩ	
				±600	200 mΩ ≤ R < 500 mΩ	
				±400	500 mΩ ≤ R < 1000 mΩ	
RTH05 (0805)	1/4W	5A	12.5A	±1500	10 mΩ ≤ R < 19 mΩ	
				±1200	19 mΩ ≤ R < 33 mΩ	
				±800	33 mΩ ≤ R < 50 mΩ	
				±600	50 mΩ ≤ R < 100 mΩ	
				±200	100 mΩ ≤ R < 1000 mΩ	
RTH06 (1206)	1/2W	7.07A	17.68A	±1500	10 mΩ ≤ R < 19 mΩ	
				±1200	19 mΩ ≤ R < 25 mΩ	
				±1000	25 mΩ ≤ R < 50 mΩ	
				±600	50 mΩ ≤ R < 100 mΩ	
				±200	100 mΩ ≤ R < 1000 mΩ	
RTH12 (1210)	3/4W	8.66A	21.6A	±1000	10 mΩ ≤ R < 25 mΩ	
				±700	25 mΩ ≤ R < 50 mΩ	
				±400	50 mΩ ≤ R < 100 mΩ	
				±200	100 mΩ ≤ R < 1000 mΩ	
RTH20 (2010)	1W	10A	25A	±200	50 mΩ ≤ R < 150 mΩ	
				±100	150 mΩ ≤ R < 1000 mΩ	
RTH25 (2512)	2W	14.14A	35.36A	±200	50 mΩ ≤ R < 150 mΩ	
				±100	150 mΩ ≤ R < 1000 mΩ	
使用溫度範圍				-55°C ~ +155°C		

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

**3.3 功率衰減曲線**

型別	RTH01 (0201)	其他型別
使用溫度範圍	-55°C ~ +125°C	-55°C ~ +155°C
說明	周圍溫度若超過70°C至125°C之間，功率可照下圖曲線予以修定之。	周圍溫度若超過70°C至125°C之間，功率可照下圖曲線予以修定之。
功率衰減曲線圖		

**3.4 額定電壓或額定電流:**

**3.4.1 阻值範圍: ≥ 1Ω**

額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值 rms)電壓。

可用下列公式求得，但求得之值若超過規格表內之最高電壓時，則以最高額定電壓為其額定電壓。

$$E = \sqrt{R \times P}$$

E=額定電壓(V)  
P=額定功率(W)  
R=公稱阻值(Ω)

**3.4.2 阻值範圍: < 1Ω**

額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值 rms)電壓。

可用下列公式求得，但求得之值若超過規格表內之最高電流時，則以最高額定電流為其額定電流。

$$I = \sqrt{P/R}$$

I=額定電流(A)  
P=額定功率(W)  
R=公稱阻值(Ω)

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

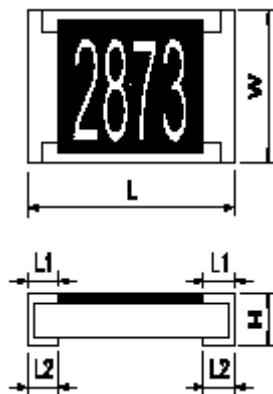
註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. **60**

#### 4 尺寸:

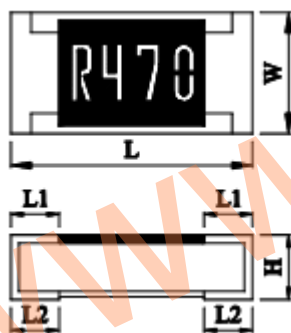
##### 4.1 阻值範圍: $\geq 1\Omega$



Unit:mm

Dimension		L	W	H	L1	L2
Type	Size Code					
RTH01	0201	0.60±0.03	0.30±0.03	0.23±0.03	0.15±0.05	0.15±0.05
RTH02	0402	1.00±0.10	0.50±0.05	0.30±0.05	0.20±0.10	0.25±0.10
RTH03	0603	1.55±0.10	0.80±0.10	0.45±0.10	0.30±0.15	0.30±0.15
RTH05	0805	2.00±0.10	1.25±0.10	0.50±0.10	0.35±0.20	0.35±0.15
RTH06	1206	3.05±0.10	1.55±0.10	0.50±0.10	0.45±0.20	0.35±0.15
RTH12	1210	3.05±0.10	2.55±0.10	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
RTH20	2010	4.95±0.10	2.45±0.10	0.70±0.10	0.65±0.20	0.60±0.20
RTH25	2512	6.40±0.20	3.20±0.20	1.05±0.10	0.60±0.20	1.25±0.20

##### 4.2 阻值範圍: $< 1\Omega$



Unit:mm

Dimension		L	W	H	L1	L2
Type	Size Code					
RTH02	0402	1.00±0.10	0.50±0.10	0.35±0.10	0.25±0.10	0.20±0.15
RTH03	0603	1.60±0.10	0.80±0.10	0.45±0.10	0.25±0.15	0.35±0.15
RTH05	0805	2.00±0.10	1.25±0.10	0.50±0.10	0.35±0.20	0.35±0.20
RTH06	1206	3.05±0.10	1.55±0.10	0.50±0.10	0.45±0.20	0.65±0.15
RTH12	1210	3.05±0.10	2.55±0.10	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
RTH20	2010	4.95±0.10	2.45±0.10	0.70±0.10	0.65±0.20	0.70±0.20
RTH25	2512	6.40±0.20	3.20±0.20	1.05±0.10	0.72±0.20	1.25±0.20

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

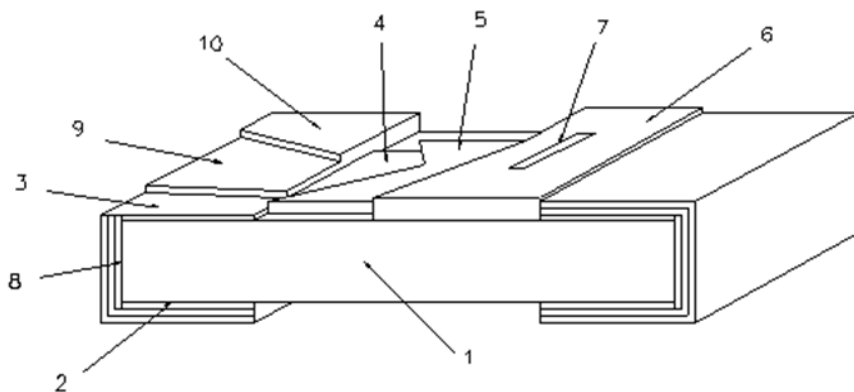
註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

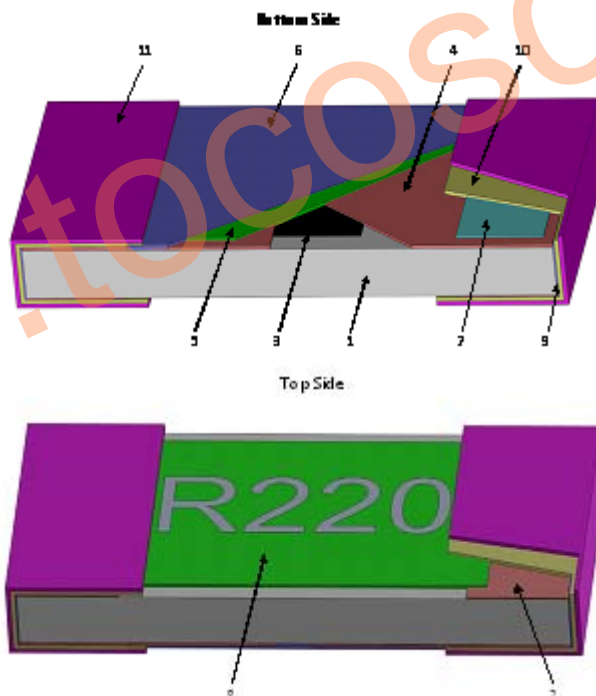
5 結構圖:

5.1 所有型別阻值範圍:  $\geq 1\Omega$  & RTH20/RTH25  $100m\Omega \leq R < \Omega$



1	陶瓷基板	Ceramic substrate	6	2nd 保護層	2nd Protective coating
2	背面內部電極	Bottom inner electrode	7	字碼	Marking
3	正面內部電極	Top inner electrode	8	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	電阻層	Resistive layer	9	Ni 層電鍍	Ni plating
5	1st 保護層	1st Protective coating	10	Sn 層電鍍	Sn plating

5.2 阻值範圍:  $< 1\Omega$  (RTH20/RTH25除外)



1	陶瓷基板	Ceramic substrate	7	2nd 正面內部電極	2nd Top inner electrode
2	1st 正面內部電極	1st Top inner electrode	8	G2+MK層	G2 layer+Marking
3	電阻層	Resistive layer	9	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	背面內部電極	Bottom inner electrode	10	Ni層電鍍	Ni plating
5	1st保護層	1st Protective coating	11	Sn層電鍍	Sn plating
6	2nd保護層	2nd Protective coating			

備

非 發 行 管 制 文 件  
自 行 注 意 版 本 更 新

發行管制章 DATA Center.

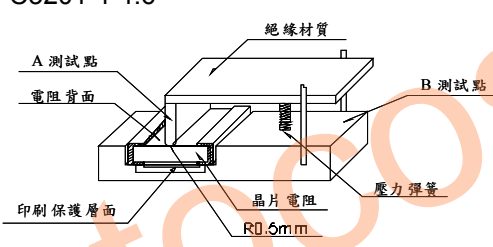
註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

6 信賴性試驗項目:

6.1 電氣性能試驗(Electrical Performance Test)

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格														
		Resistors														
Temperature Coefficient of Resistance 溫度係數	$TCR \text{ (ppm/}^\circ\text{C)} = \frac{R2 - R1}{R1 (T2 - T1)} \times 10^6$ R1:室溫下量測之阻值(Ω) R2:-55°C或+125°C下量測之阻值(Ω) T1:室溫之溫度(°C) T2:-55°C或+125°C之溫度(°C)。 依據 JIS-C5201-1 4.8	參考3.規格表														
Short Time Overload 短時間過負荷	施加2.5倍的額定電壓5秒，靜置30分鐘以上再量測阻值變化率。(額定電壓值請參考 3.規格表)  依據 JIS-C5201-1 4.13	1.阻值範圍:≥ 1Ω 1%:±(1.0%+0.05Ω) 2%、5%:±(2.0%+0.10Ω) 2.阻值範圍:< 1Ω 1%、2%、5% :±(2.0%+0.001Ω) 外觀無損傷，無短路或燒毀現象。														
Insulation Resistance 絕緣電阻試驗	將晶片電阻置於治具上，在正負極施加100VDC一分鐘後，測量電極與保護層及電極與基板(底材)間之絕緣電阻值 依據 JIS-C5201-1 4.6  	≥ 10 <sup>9</sup> Ω														
Dielectric Withstand Voltage 絕緣耐電壓	將晶片電阻置於治具上，在正、負極施加VAC (參考下列) RTH05、06、12、20、25 用500VAC一分鐘 RTH02、03用300VAC一分鐘 依據 JIS-C5201-1 4.7	無短路或燒毀現象。														
Noise Level 雜音測驗	依據 JIS-C5201-1 4.12 測試方法。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>阻值範圍</th> <th>雜音(Noise)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R &lt; 100Ω</td> <td>≤ -10db (0.32 uV/V)</td> </tr> <tr> <td>100Ω ≤ R &lt; 1KΩ</td> <td>≤ 0db (1.0 uV/V)</td> </tr> <tr> <td>1KΩ ≤ R &lt; 10KΩ</td> <td>≤ 10db (3.2 uV/V)</td> </tr> <tr> <td>10KΩ ≤ R &lt; 100KΩ</td> <td>≤ 15db (5.6 uV/V)</td> </tr> <tr> <td>100KΩ ≤ R &lt; 1MΩ</td> <td>≤ 20db (10 uV/V)</td> </tr> <tr> <td>1MΩ ≤ R</td> <td>≤ 30db (32 uV/V)</td> </tr> </tbody> </table>	阻值範圍	雜音(Noise)	R < 100Ω	≤ -10db (0.32 uV/V)	100Ω ≤ R < 1KΩ	≤ 0db (1.0 uV/V)	1KΩ ≤ R < 10KΩ	≤ 10db (3.2 uV/V)	10KΩ ≤ R < 100KΩ	≤ 15db (5.6 uV/V)	100KΩ ≤ R < 1MΩ	≤ 20db (10 uV/V)	1MΩ ≤ R	≤ 30db (32 uV/V)
阻值範圍	雜音(Noise)															
R < 100Ω	≤ -10db (0.32 uV/V)															
100Ω ≤ R < 1KΩ	≤ 0db (1.0 uV/V)															
1KΩ ≤ R < 10KΩ	≤ 10db (3.2 uV/V)															
10KΩ ≤ R < 100KΩ	≤ 15db (5.6 uV/V)															
100KΩ ≤ R < 1MΩ	≤ 20db (10 uV/V)															
1MΩ ≤ R	≤ 30db (32 uV/V)															

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

**6.2 機械性能試驗(Mechanical Performance Test)**

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格
		Resistors
Core Body Strength 本體強度	使用R0.5的測試探針在本體中央向下施加10N { 1.02 kgf } 的負載持續10 sec。 1.RTH02、03測試探針R0.2mm 2.RTH05、06、12、20、25 測試探針R0.5mm 依據 JIS-C5201-1 4.15	1.阻值範圍: $\geq 1\Omega$ $\pm(1.0\%+0.05\Omega)$ 2.阻值範圍: $< 1\Omega$ $\pm(1.0\%+0.001\Omega)$ 外觀無損傷, 側導無裂痕
Terminal Strength 端電極拉力測試	測試項目一:將電阻焊在電路板上, 在電阻背面施以5N (RTH01:3N)的力量持續10sec後, 檢查側導體外觀。 測試項目二:將電阻焊在電路板上, 逐漸施加力量於電阻背面, 測試端電極最大剝離強度。 依據 JIS-C5201-1 4.16	項目一:外觀無損傷, 無側導脫落及本體斷裂發生。 項目二:RTH03 $\geq 3N$ Other $\geq 5N$
Resistance to Solvent 耐溶劑性試驗	浸於20~25°C異丙醇溶劑中5 $\pm$ 0.5分鐘後, 取出靜置48hr以上, 再量測阻值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.29	1.阻值範圍: $\geq 1\Omega$ $\pm(0.5\%+0.05\Omega)$ 2.阻值範圍: $< 1\Omega$ $\pm(1.0\%+0.001\Omega)$ 外觀無損傷, 無G2保護層及錫層被Leaching現象。
Solderability 焊錫性	前處理: 將晶片電阻放置於PCT試驗機內, 在溫度105°C、濕度100%及氣壓1.22 $\times 10^5$ pa的飽和條件下進行4小時的老化測試, 取出後靜置於室溫下2小時。 測試方法:將電阻浸於235 $\pm 3^\circ C$ 之爐中2 $\pm 0.5$ 秒後取出置於顯微鏡下觀察焊錫面積。 依據 JIS-C5201-1 4.17	1.試驗項目一: 導體吃錫面積應大於95%。
Resistance to Soldering Heat 抗焊錫熱	◎測試項目一(焊錫爐測試): 浸於260+5/-0°C之錫爐中10 秒+1/-0, 取出靜置60分鐘以上, 再量測阻值變化率。 ◎測試項目二(焊錫爐測試) 浸於260+5/-0°C之錫爐中30+1/-0秒, 取出後洗淨。置於顯微鏡下觀察焊錫面積。 ◎測試項目三(電烙鐵試驗): 加熱溫度:350 $\pm 10^\circ C$ 電烙鐵加熱時間:3+1/-0 sec。 取電烙鐵加熱於電極兩端後, 取出靜置60分鐘以上, 再量測阻值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.18	試驗項目一: (1).阻值變化率 1.阻值範圍: $\geq 1\Omega$ $\Delta R\% = \pm(1.0\%+0.05\Omega)$ 2.阻值範圍: $< 1\Omega$ $\Delta R\% = \pm(1.0\%+0.001\Omega)$ (2).電極外觀無異常, 無側導脫落。 試驗項目二: (1).導體吃錫面積應大於95%。 (2).在電極邊緣處不應見到下層的物質(例如白基板)。 試驗項目三: (1).阻值變化率 1.阻值範圍: $\geq 1\Omega$ $\Delta R\% = \pm(1.0\%+0.05\Omega)$ 2.阻值範圍: $< 1\Omega$ $\Delta R\% = \pm(1.0\%+0.001\Omega)$ (2).電極外觀無異常, 無側導脫落。

備

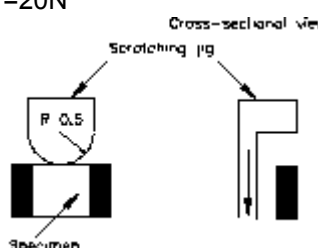
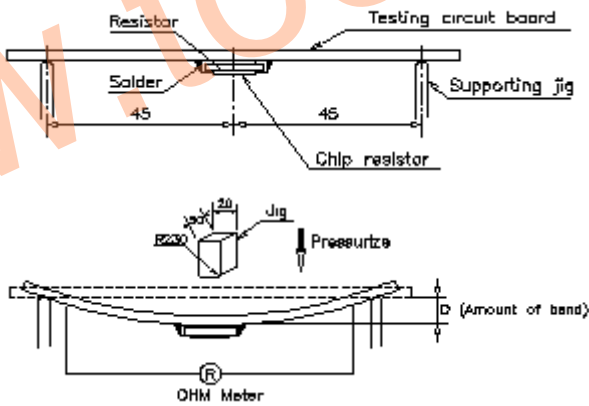
非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許, 禁止自行影印文件

Series No. 60

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格
		Resistors
Joint Strength of Solder 焊錫粘合強度	<p>前處理: 將晶片電阻放置於PCT試驗機內, 在溫度105°C、濕度100%及氣壓<math>1.22 \times 10^5</math> pa的飽和條件下進行4小時的老化測試, 取出後靜置於室溫下2小時。</p> <p>◎測試項目一(固著性測試): 將晶片電阻焊於固著性測試板中, 置於端電極測試機上, 以半徑R0.5之測試探針朝施力方向施加力量, 並保持10sec, 於負荷下量測阻值變化率。</p> <p>力量: 1.RTH01=5N 2.RTH02=10N 3.其它型別=20N</p>  <p>依據JIS-C5201-1 4.32</p> <p>◎測試項目二(彎折性測試): 將晶片電阻焊於彎折性測試板中, 置於彎折測試機上, 在測試板中央施力下壓, 於負荷下量測阻值變化率。</p> <p>下壓深度(D): RTH02、03、05=5mm RTH01、06、12=3mm RTH20、25=2mm</p>  <p>依據JIS-C5201-1 4.33</p>	<p>試驗項目一:</p> <p>(一).阻值變化率</p> <p>1.阻值範圍:<math>\geq 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.05\Omega)</math></p> <p>2.阻值範圍:<math>&lt; 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.001\Omega)</math></p> <p>(二).外觀無損傷、無側導脫落。</p> <p>試驗項目二:</p> <p>(一).阻值變化率</p> <p>1.阻值範圍:<math>\geq 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.05\Omega)</math></p> <p>2.阻值範圍:<math>&lt; 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.001\Omega)</math></p> <p>(二).外觀無損傷、無側導脫落及本體斷裂發生。</p>
Vibration 耐振性試驗	<p>將晶片電阻焊於測試板上施加一振動波</p> <p>震動頻率:10Hz ~ 55Hz ~ 10Hz/分</p> <p>振幅:1.5mm</p> <p>測試時間:6hrs(X.Y.Z3個方向各2hrs)</p> <p>依據 JIS-C5201-1 4.22</p>	<p>1.阻值範圍:<math>\geq 1\Omega</math> 1%:<math>\pm(0.5\% + 0.05\Omega)</math> 2%、5%:<math>\pm(1.0\% + 0.05\Omega)</math></p> <p>2.阻值範圍:<math>&lt; 1\Omega</math> 1%、2%、5%:<math>\pm(1.0\% + 0.001\Omega)</math></p> <p>外觀無損傷</p>

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許, 禁止自行影印文件

Series No. 60



**6.3 環境試驗(Environmental Test)**

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格										
		Resistors										
Resistance to Dry Heat 耐熱性試驗	置於155±5°C之烤箱中1000+48/-0 hrs，取出靜置1hr以上再量測阻值變化率。  依據 JIS-C5201-1 4.25	1.阻值範圍:≥1Ω 1%:±(1.0%+0.05Ω) 2%、5%:±(2.0%+0.10Ω) 2.阻值範圍:<1Ω 1%、2%、5% :±(1.0%+0.001Ω) 外觀無損傷，無短路及燒毀現象。										
Thermal Shock 冷熱沖擊	將晶片電阻置入冷熱沖擊機中，溫度為-55°C 15分鐘，+125°C 15分鐘，共計循環300次後取出，靜置60分鐘再量測阻值變化率。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="2">測試條件</th></tr> <tr><td>最低溫度</td><td>-55±5°C</td></tr> <tr><td>最高溫度</td><td>125±5°C</td></tr> <tr><td>溫度保留時間</td><td>15 分鐘</td></tr> </table> 依據 MIL-STD 202 Method 107	測試條件		最低溫度	-55±5°C	最高溫度	125±5°C	溫度保留時間	15 分鐘	1.阻值範圍:≥1Ω 1%:±(0.5%+0.05Ω) 2%、5%:±(1.0%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1Ω 1%、2%、5% :±(1.0%+0.001Ω) 外觀無損傷，無短路及燒毀現象。		
測試條件												
最低溫度	-55±5°C											
最高溫度	125±5°C											
溫度保留時間	15 分鐘											
Loading Life in Moisture 耐濕負荷	置於溫度40±2°C相對濕度90~95%恆溫恆濕槽中，並施加額定電壓，90分鐘ON，30分鐘OFF，共1,000hrs取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。  依據 JIS-C5201-1 4.24	1.阻值範圍:≥1Ω 1%:±(0.5%+0.05Ω) 2%、5%:±(2.0%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1Ω 1%、2%、5% :±(2.0%+0.001Ω) 外觀無損傷，無短路及燒毀現象。										
Load Life 負荷壽命	置於70±2°C之烤箱中施加額定電壓，90分鐘ON，30分鐘OFF，共1,000 hrs取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。  依據 JIS-C5201-1 4.25	1.阻值範圍:≥1Ω 1%:±(0.5%+0.05Ω) 2%、5%:±(2.0%+0.10Ω) 2.阻值範圍:<1Ω 1%、2%、5% :±(2.0%+0.001Ω) 外觀無損傷，無短路及燒毀現象。										
Low Temperature Operation 低溫操作	將晶片電阻放置-55°C恆溫箱中60分鐘，施加額定電壓45分鐘，停止施壓15分鐘取出後靜置8±1hr再量測阻值變化率。  依據MIL-R-55342D 4.7.4	1.阻值範圍:≥1Ω 1%:±(0.5%+0.05Ω) 2%、5%:±(1.0%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1Ω 1%、2%、5% :±(1.0%+0.001Ω) 外觀無損傷，無短路及燒毀現象。										
Whisker 試驗	◎測試項目(冷熱衝擊測試): 將晶片電阻置放於冷熱衝擊試驗箱內，並依下列條件做測試，試驗後置於室溫下2小時。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="2">測試條件</th></tr> <tr><td>最低儲存溫度</td><td>-55+0/-10°C</td></tr> <tr><td>最高儲存溫度</td><td>85+10/-0°C</td></tr> <tr><td>溫度保留時間</td><td>10分</td></tr> <tr><td>溫度循環次數</td><td>1,500</td></tr> </table> ◎檢查 將放大鏡的倍數調至40或大於40的倍數下做視察和測試，如果此方法難做出判斷，我們可以改用掃描電子顯微鏡(SEM)，且將倍數調至1000或大於1000倍數下做視察和測試。 依據JESD Standard NO.22A121 class2.	測試條件		最低儲存溫度	-55+0/-10°C	最高儲存溫度	85+10/-0°C	溫度保留時間	10分	溫度循環次數	1,500	Whisker長度在50µm之內。
測試條件												
最低儲存溫度	-55+0/-10°C											
最高儲存溫度	85+10/-0°C											
溫度保留時間	10分											
溫度循環次數	1,500											

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

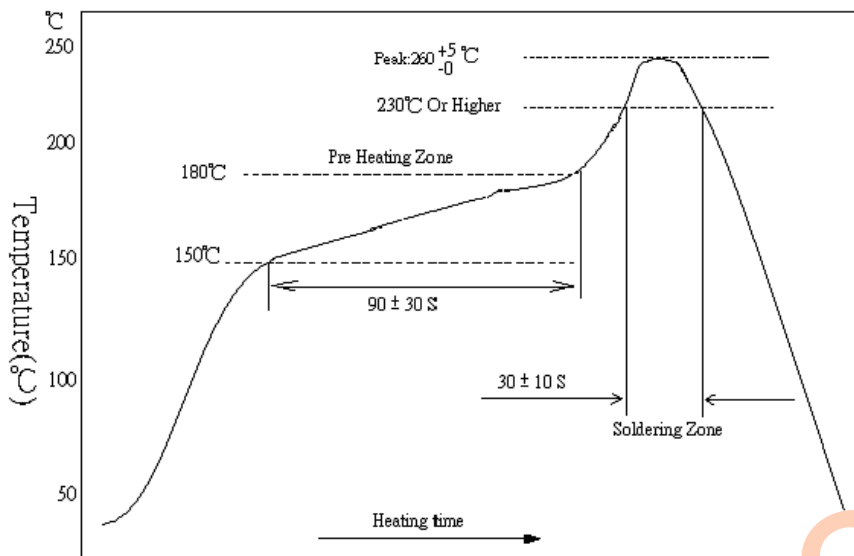
註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

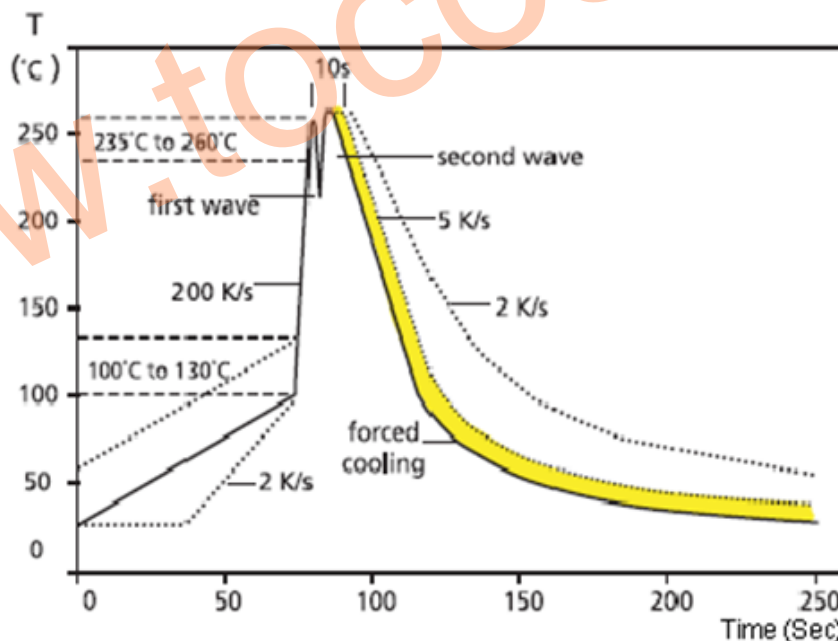
7 建議焊錫條件:

7.1 Lead Free IR Reflow Soldering Profile



備註:零件最高耐溫 $260 +5/-0$  °C,10秒。

7.2 Lead Free Double-Wave Soldering Profile(適用0603(含)以上之產品)



7.3 烙鐵焊錫方法: $350 \pm 10$ °C 3秒之內。

備註

非發行管制文件  
自行注意版本更新

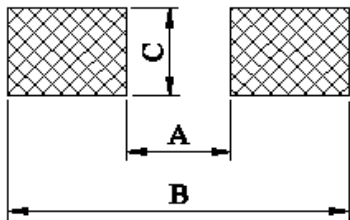
非經允許，禁止自行影印文件

發行管制章 DATA Center.

Series No. 60

8 建議Land Pattern Design(For Reflow Soldering) :

Unit:mm



DIM TYPE	A	B	C
RTH01	0.3	1.0	0.4
RTH02	0.5	1.5	0.6
RTH03	0.8	2.1	0.9
RTH05	1.2	3.0	1.3
RTH06	2.2	4.2	1.6
RTH12	2.2	4.2	2.8
RTH20	3.5	6.1	2.8
RTH25	3.8	8.0	3.5

9 鍍層厚度:

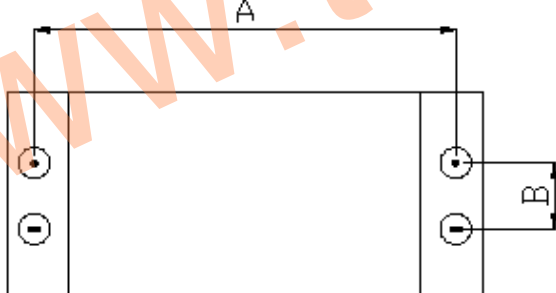
9.1 鍍層厚度:  $\geq 2\mu\text{m}$

9.2 純錫:  $\geq 3\mu\text{m}$

9.3 電鍍純錫為霧錫

10 阻值測試包裝標準量測位置:

背面電極量測		Unit : mm	
DIM TYPE	A	B	
RTH01	0.44±0.05	0.22±0.05	
RTH02	0.80±0.05	0.24±0.05	
RTH03	1.35±0.05	0.35±0.05	
RTH05	1.80±0.05	0.35±0.05	
RTH06	2.90±0.05	0.35±0.05	
RTH12	2.90±0.05	0.35±0.05	
RTH20	4.50±0.05	1.15±0.05	
RTH25	5.90±0.05	1.60±0.05	



⊕ Current Terminal

⊖ Voltage Terminal

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註


非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

**11 儲存期限:**

11.1 在儲存環境 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、 $60\pm 15\%$ 之條件下可儲存二年。

**12 電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示:(外銷中國大陸)**

	
<p>電子信息產品污染控制標誌</p>	<p>包裝回收標誌</p>

**13 附件:**

13.1 文件修訂記錄表 (QA-QR-027)

www.tocosc.com

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60